

"SUPER SOT" SOT23 PNP SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTOR

ISSUE 1 – AUGUST 1997

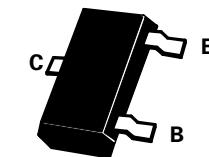
FMMT734

FEATURES

- * **625mW POWER DISSIPATION**
- * Very High h_{FE} at High Current (5A)
- * Extremely Low $V_{CE(sat)}$ at High Current (1A)

COMPLEMENTARY TYPE – FMMT634

PARTMARKING DETAIL – 734



SOT23

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-100	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-12	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-5	A
Continuous Collector Current	I_C	-800	mA
Power Dissipation	P_{tot}	625	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j:T_{stg}$	-55 to +150	°C

* Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on a ceramic substrate measuring 15x15x0.6mm

**Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤ 2%

FMMT734

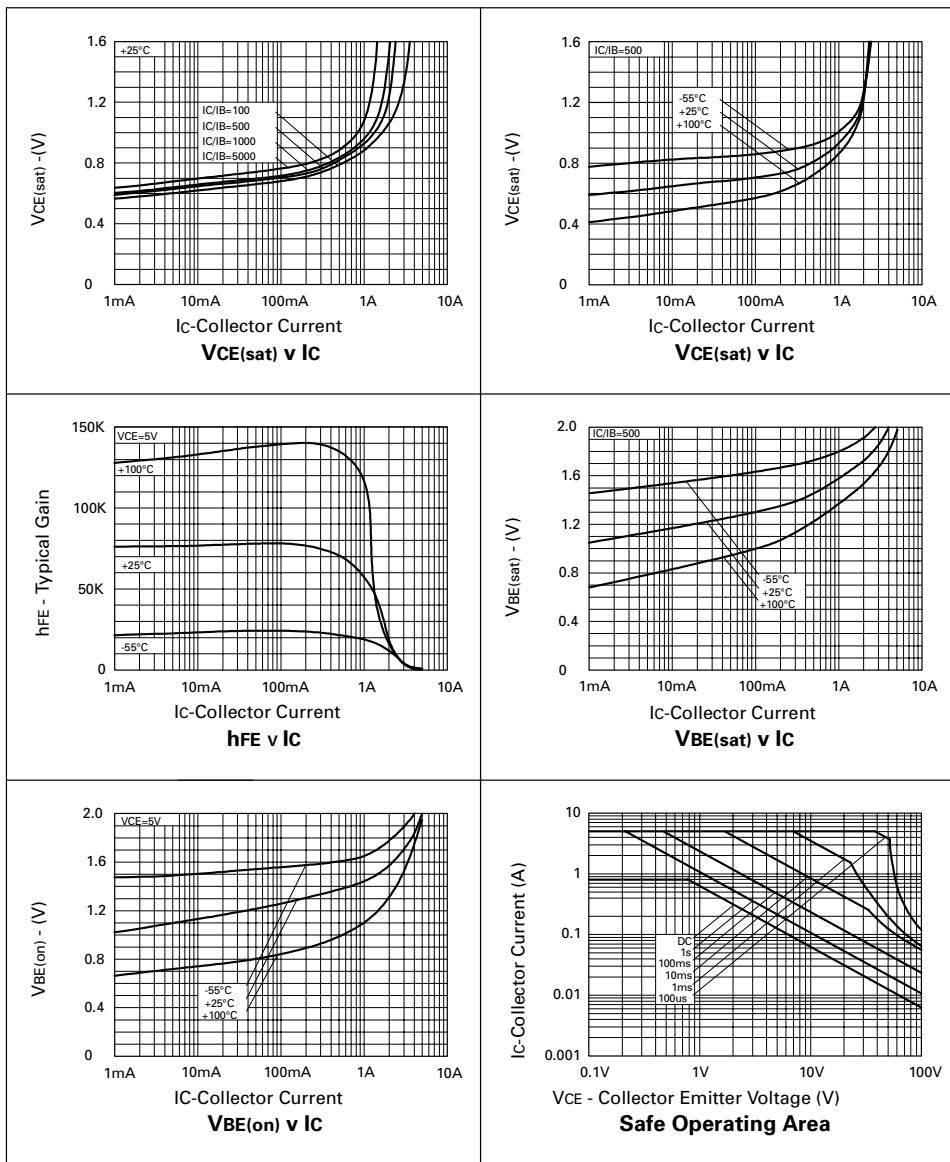
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-100	-130		V	$I_C=-100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-100	-116		V	$I_C=-5mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-12	-17		V	$I_E=-100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-10	nA	$V_{CB}=-80V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-10	nA	$V_{EB}=-7V$
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}			-200	nA	$V_{CES}=-80V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.68 -0.72 -0.78 -0.86 -0.72 -0.90	-0.75 -0.80 -0.86 -0.97 — -1.05	V	$I_C=-100mA, I_B=-1mA^*$ $I_C=-250mA, I_B=-1mA^*$ $I_C=-500mA, I_B=-5mA^*$ $I_C=-800mA, I_B=-5mA^*$ $I_C=-800mA, I_B=-5mA$ †* $I_C=-1A, I_B=-5mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-1.60	-1.75	V	$I_C=-1A, I_B=-5mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-1.30	-1.75	V	$I_C=-1A, V_{CE}=-5V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	20K 15K 5K	60K 60K 50K 15K 150 20K			$I_C=-10mA, V_{CE}=-5V^*$ $I_C=-100mA, V_{CE}=-5V^*$ $I_C=-1A, V_{CE}=-5V^*$ $I_C=-2A, V_{CE}=-5V^*$ $I_C=-5A, V_{CE}=-5V^*$ $I_C=-1A, V_{CE}=-2V^*$
Transition Frequency	f_T		140		MHz	$I_C=-10mA, V_{CE}=-10V$ $f=100MHz$
Output Capacitance	C_{obo}		14	25	pF	$V_{CB}=-10V, f=1MHz$
Turn-On Time	$t_{(on)}$		460		ns	$I_C=-500mA, V_{CC}=-20V$ $I_B=\pm 1mA$
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		1200		ns	

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤ 2%

† $T_{amb}=150^\circ C$

TYPICAL CHARACTERISTICS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.